

適用規格		microSD Memory Card Specifications Ver 1.10			
定 格	使用温度範囲	-25 °C ~ +85 °C(注1)	保存温度範囲	-40 °C ~ +85 °C	
	電 圧	AC 125 V	使用湿度範囲	相対湿度95%以下 (ただし、結露しないこと。)	
	電 流	0.5 A			
性 能					
	項 目	試 験 方 法	規 格	QT	AT
構造	外観・構造・仕上げ	目視，寸法測定器にて測定する。	図面と合致していること。	○	○
	表示	目視にて確認する。		○	○
電 気 的 性 能	低電圧，低電流下の接触抵抗 IEC60512-2-2a	開放電圧20 mV、試験電流1 mA で測定する。	100mΩ以下（初期値）。（注2）	○	—
	耐 電 圧 IEC60512-2-4a	AC 500Vrmsの電圧を1分間印加する。	①せん絡・絶縁破壊がないこと。 ②漏洩電流 1 mA以下。	○	○
	絶 縁 抵 抗 IEC60512-2-3a	DC 500Vの電圧を印可し1分以内に測定する。	1000MΩ以上（初期値）。	○	—
機 械 的 性 能	カード挿入操作力	スピード25mm/minにて適合カードで測定する。	初期：12N以下 挿抜寿命後：15N以下	○	—
	カード引き抜き操作力		初期：12N以下 挿抜寿命後：15N以下	○	—
	挿抜寿命 (オフィス環境) EIA364b class1.1	1分間に10サイクル以下の速度で、10,000サイクルの挿抜を行う。 ※10サイクルごとに5～10分間は繰り返し動作を休止させる。 また、 a) 初期～1,000サイクル：100回毎、計10回 b) 1,000～10,000サイクル：1,000回毎、計9回の各休止時に、エアブローにより、カード表面への付着物を除去させる。	①接触抵抗：初期からの変化量 40mΩ以下。（挿抜により接触抵抗値が復帰すれば可。） ②極度の摩耗や破損等の異常がないこと。	○	—
	振動・高周波 IEC60512-4-6d	片振幅0.75mm、周波数10～55～10Hzの振動をX、Y、Z軸3方向各4時間、計12時間加える。	①100ns以上の瞬断がないこと。 ②破損、ひび、部品のゆるみがないこと。	○	—
	衝 撃 IEC60512-4-6c	加速度490m/s ² 、持続時間11msの正弦半波で3軸方向各3回、計18回の衝撃を加える。	①100ns以上の瞬断がないこと。 ②破損、ひび、部品のゆるみがないこと。	○	—
	△の数	訂正記事	設計	検図	年月日
△					
備考（注1）通電による温度上昇を含む。 （注2）接触抵抗は導体抵抗を含む。 規定無き場合は温度15℃～35℃、気圧86～106kPa、湿度25～85%の試験環境下にて実施のこと。			承認	KI. AKIYAMA	08.09.03
			検 図	SI. TOMIOKA	08.09.03
			担 当	KJ. NISHIWAKI	08.09.02
			製 図	KJ. NISHIWAKI	08.09.02
注 QT:確認試験 AT:製品検査 ○:適用項目		図番	SLC4-158563-00		
HRS	製 品 規 格 表		製品名	DM3BT-DSF-PEJS	
	ヒロセ電機株式会社		製品コード	CL609-0029-9-00	△ 1/2

性		能	
項目	試験方法	規格	QTAT
環境性能	温湿度サイクル IEC60512-6-11m 	①接触抵抗：初期からの変化量 40mΩ以下。 ②絶縁抵抗：100MΩ以上。 ③機能を損なう腐食や破損等の異常なきこと。	○—
	熱衝撃 IEC60512-6-11d 温度 -55～ +85℃、変化時間 5分以内で5サイクル（1サイクル=1h）の嵌合放置をする。	①接触抵抗：初期からの変化量 40mΩ以下 ②絶縁抵抗：100MΩ以上 ③機能を損なう腐食や破損等の異常なきこと。	○—
	耐熱性 IEC60512-6-11i 温度 +85℃に 96hの嵌合放置をする。	①接触抵抗：初期からの変化量 40mΩ以下 ②絶縁抵抗：100MΩ以上 ③機能を損なう腐食や破損等の異常なきこと。	○—
	耐寒性 IEC60512-6-11j 温度 -25℃に 96hの嵌合放置をする。	①接触抵抗：初期からの変化量 40mΩ以下 ②絶縁抵抗：100MΩ以上 ③機能を損なう腐食や破損等の異常なきこと。	○—
	耐湿 （定常状態） IEC60512-6-11c 温度+40℃、湿度 90～95%RH中に96hの嵌合放置をする。	①接触抵抗：初期からの変化量 40mΩ以下 ②絶縁抵抗：100MΩ以上 ③機能を損なう腐食や破損等の異常なきこと。	○—
	硫化水素ガス JEIDA 38 温度+40℃、湿度80%RH、H ₂ S 3ppmのガス中に96hの嵌合放置をする。	①接触抵抗：初期からの変化量 40mΩ以下 ②絶縁抵抗：100MΩ以上 ③機能を損なう腐食や破損等の異常なきこと。	○—
注 QT:確認試験 AT:製品検査 ○:適用項目		図番	SLC4-158563-00
HS	製品規格表	製品名	DM3BT-DSF-PEJS
	ヒロセ電機株式会社	製品コード	CL609-0029-9-00